

10/0857204



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月26日

出願番号

Application Number:

特願2001-051253

[ST.10/C]:

[JP2001-051253]

出願人

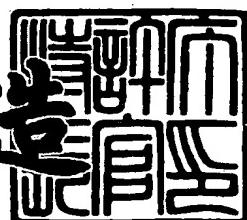
Applicant(s):

株式会社リコー

2002年 5月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3035034

【書類名】 特許願
 【整理番号】 0100946
 【提出日】 平成13年 2月26日
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 G02B 6/42
 【発明の名称】 光通信システムおよび光送受信システム
 【請求項の数】 3
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 株式会社リコー内
 【氏名】 古田 輝幸
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 株式会社リコー内
 【氏名】 桜井 彰
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 株式会社リコー内
 【氏名】 加藤 正良
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 株式会社リコー内
 【氏名】 宮垣 一也
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
 株式会社リコー内
 【氏名】 金井 健
 【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(●) 株式会社リコー内

【氏名】 和多田 篤行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 俊一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 鈴木 幸栄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 菅原 悟

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 新治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 夷地 秀一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 関谷 卓朗

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】 桜井 正光

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003724

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光通信システムおよび光送受信システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザチップと該レーザチップと光学的にカップリングされる第1の光ファイバーと該第1の光ファイバーと光学的にカップリングされる第2の光ファイバーのケーブルとよりなる光通信システムにおいて、前記レーザチップは発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料層は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$)とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源としたものであり、前記第1の光ファイバーはその長さを1mm以上としたことを特徴とする光通信システム。

【請求項2】 レーザチップと該レーザチップと光学的にカップリングされる第1の光ファイバーと該第1の光ファイバーと光学的にカップリングされる第2の光ファイバーのケーブルとよりなる光通信システムにおいて、前記レーザチップは発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$)とした反射鏡であり、前記活性層と前記反射鏡の間に

GaInPもしくはGaInPAsよりなる非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源としたものであり、前記第1の光ファイバーはその長さを1mm以上としたことを特徴とする光通信システム。

【請求項3】 請求項1もしくは請求項2の光通信システムの第2の光ファイバーのケーブルと光学的にカップリングされ、光を受光する受光ユニットを組合せた光送受信システムにおいて、前記受光ユニットは、前記第2の光ファイバーのケーブルと光学的にカップリングされる第3の光ファイバーと該第3の光ファイバーと光学的にカップリングされる受光素子よりなるとともに、前記第3の光ファイバーはその長さを1mm以上としたことを特徴とする光送受信システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は光通信などに用いられる半導体レーザならびにその光通信システムおよび光送受信システムに関するものであり、中でも半導体レーザとして製作に使用する半導体基板面に対して垂直方向に光を発するいわゆる面発光レーザを用い複数のレーザ素子を形成して、大容量の通信を可能にした光通信システムおよび光送受信システムに関する。

【0002】

【従来の技術】

面発光半導体レーザは、基板の表面から垂直方向にレーザ光を放射するので2次元並列集積が可能であり、更に、その出力光の広がり角が比較的狭い（10度前後）ので光ファイバとの結合が容易であるほか、素子の検査が容易であるという特徴を有している。そのため、特に、並列伝送型の光送信モジュール（光インタコネクション装置）を構成するのに適した素子として開発が盛んに行なわれている。光インタコネクション装置の当面の応用対象は、コンピュータ等の筐体間やボード間の並列接続のほか、短距離の光ファイバー通信であるが、将来の期待される応用として大規模なコンピュータ・ネットワークや長距離大容量通信の幹線系がある。

【0003】

一般に、面発光半導体レーザは、GaAs 又はGaInAs からなる活性層と、当該活性層を上下に挟んで配置された上部の半導体分布布拉格反射鏡と基板側の下部の半導体分布布拉格反射鏡からなる光共振器をもって構成するのが普通であるが、端面発光型半導体レーザの場合に比較して光共振器の長さが著しく短いため、反射鏡の反射率を極めて高い値(99%以上)に設定することによってレーザ発振を起こし易くする必要がある。このため、通常は、AlAs からなる低屈折率材料とGaAs からなる高屈折率材料を1/4波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布布拉格反射鏡が使用されている。

【0004】

ところで上記のように、光通信に使用されるようなレーザ波長が1.1μm以上の長波長帯レーザ、例えばレーザ波長が1.3μm帯や1.55μm帯のような長波長帯レーザは、製作基板にInPが用いられ、活性層にInGaAsPが用いられるが、基板のInPの格子定数が大きく、これに整合する反射鏡材料では屈折率差が大きく取れず、従って積層数を40対以上とする必要がある。またInP基板上に形成される半導体レーザには、別の問題として、温度によって特性が大きく変化する点がある。そのため、温度を一定にする装置を附加して使用する必要があり、民生用等一般用に供することが困難であり、このような積層数と温度特性の問題から、実用的な長波長帯面発光半導体は、未だ実用化されるに至っていない。

【0005】

このような問題を解決するためになされた発明として、特開平9-237942号公報に開示されたものが知られている。それによると、製作基板としてGaAs 基板を用い、基板側の下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布布拉格反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れるAlInPからなる半導体層を用い、さらに、下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布布拉格反射鏡の高屈折率層にGaInNAsからなる半導体層を用い、従来よりも大きい屈折率差を得るようにし、少ない積層数で高反射率の半導体分布布拉格反射鏡を実現しようというものである。

【0006】

また、 GaInNAs を活性層の材料として使用している。これは、N組成を増加させることによってバンドギャップ（禁制帯幅）を 1.4 eV から 0 eV へ向かって低下させることができるので、 $0.85\mu\text{m}$ よりも長い波長を発光する材料として用いることが可能となるからである。しかも GaAs 基板と格子整合が可能なので、 GaInNAs からなる半導体層は、 $1.3\mu\text{m}$ 帯及び $1.55\mu\text{m}$ 帯の長波長帯面発光半導体レーザのための材料として好ましい点についても言及している。

【0007】

しかしながら、従来は $0.85\mu\text{m}$ よりも長い波長帯の面発光半導体レーザ実現の可能性を示唆するにとどまっているだけであり、実際にはそのようなものは実現していない。これは基本的な構成は理論的にはほぼ決まっているものの実際に安定したレーザ発光が得られるようにするためにより具体的な構成がまだ不明だからである。

【0008】

一例を挙げると、上記のように AlAs からなる低屈折率材料と GaAs からなる高屈折率材料を $1/4$ 波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布プラグ反射鏡を使用したものや、あるいは特開平9-237942号公報に開示されたもののように、半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れる AlInP からなる半導体層を用いたものにおいては、レーザ素子が全く発光しなかったり、あるいは、発光してもその発光効率が低く、実用レベルには程遠いものであった。これは、 Al を含んだ材料が化学的に非常に活性であり、 Al に起因する結晶欠陥が生じ易いためである。これを解決するためには、特開平8-340146号公報や特開平7-307525号公報に開示された発明のように Al を含まない GaInNP と GaAs とから半導体分布プラグ反射鏡を構成する提案がある。しかしながら GaInNP と GaAs との屈折率差は AlAs と GaAs との屈折率差に比べて約半分であり、反射鏡の積層数を非常に多くなり製作が困難となる。

【0009】

すなわち現状では、コンピュータ・ネットワークなどで光ファイバー通信が期待されているが、それに使用できるレーザ波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた通信システムが存在せず、その出現が切望されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような光通信などに用いられるレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザならびにその光通信システムに関するものであり、その第1の目的は、動作電圧、発振閾値電流等を低くできる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源として利用し、当該面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長を一定長以上とすることで当該パッケージのアセンブリ製作の生産性の向上を図るとともに、容易に光通信システムを構築できるようにすることにある。

【0011】

また第2の目的も、安定して使用できるレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザ素子チップを発光光源として利用し、当該面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長を一定長以上とすることで当該パッケージのアセンブリ製作の生産性の向上を図るとともに、容易に光通信システムを構築できるようにすることにある。

【0012】

さらに第3の目的は、このようなレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザ素子チップを発光光源として用いる光送受信システムの受光ユニットにおいても、上記のようなモジュールパッケージと同様に、受光ユニットから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長を一定長以上とすることで当該受光ユニットのアセンブリ製作の生産性の向上を図るとともに、容易に光送受信システムを構築できるようにすることにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明は前記目的を達成するために第1に、レーザチップと該レーザチップと光学的にカップリングされる第1の光ファイバーと該第1の光ファイバーと光学的にカップリングされる第2の光ファイバーのケーブルとよりなる光通信システムにおいて、前記レーザチップは発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料層は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源としたものであり、前記第1の光ファイバーはその長さを1mm以上とするようにした。

【0014】

また第2に、レーザチップと該レーザチップと光学的にカップリングされる第1の光ファイバーと該第1の光ファイバーと光学的にカップリングされる第2の光ファイバーのケーブルとよりなる光通信システムにおいて、前記レーザチップは発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}\sim1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、前記活性層と前記反射鏡の間にGaInPもしくはGaInPAsよりなる非発光再結合防止層を設けてなる面発光

型半導体レーザ素子チップを発光光源としたものであり、前記第1の光ファイバーはその長さを1mm以上とするようにした。

【0015】

さらに第3に、上記第1および第2の光通信システムを用いた光送受信システムにおいて、第2の光ファイバーのケーブルと光学的にカップリングされ、光を受光する受光ユニットを組合せた光送受信システムにおいて、前記受光ユニットは、前記第2の光ファイバーのケーブルと光学的にカップリングされる第3の光ファイバーと該第3の光ファイバーと光学的にカップリングされる受光素子になるととともに、前記第3の光ファイバーはその長さを1mm以上とするようにした。

【0016】

【発明の実施の形態】

最初に本発明の光通信システムに適用される発光素子である伝送ロスの少ないレーザ発振波長が1.1μm～1.7μmの長波長帯面発光半導体レーザの1例について図1を用いて説明する。

【0017】

前述のように、従来は本発明が適用しようとしているレーザ発振波長が1.1μm～1.7μmの長波長帯面発光半導体レーザに関しては、その可能性の示唆があるのみで、実現のための材料、ならびにより具体的、詳細な構成は不明であった。本発明では、活性層としてGaInNAs等の材料を使用し、さらに具体的な構成を明確にした。以下にそれを詳述する。

【0018】

本発明では、面方位(100)のn-GaAs基板上に、それぞれの媒質内における発振波長λの1/4倍の厚さ(λ/4の厚さ)でn-Al_xGa_{1-x}As(x=1.0)(低屈折率層～屈折率小の層)とn-Al_yGa_{1-y}As(y=0)(高屈折率層～屈折率大の層)を交互に35周期積層したn-半導体分布ブレッジ反射鏡(AlAs/GaAs下部半導体分布ブレッジ反射鏡)を形成し、その上にλ/4の厚さのn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5,y=1)層を積層した。この例ではn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5,y=1)層も下部反射鏡

の一部であり低屈折率層（屈折率小の層）となっている。

【0019】

そしてその上にアンドープ下部GaAsスペーサ層と、3層の $Ga_xIn_{1-x}As$ 量子井戸層である活性層（量子井戸活性層）とGaAsバリア層（20nm）からなる多重量子井戸活性層と、アンドープ上部GaAsスペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長 λ の1波長分の厚さ（ λ の厚さ）の共振器を形成している。

【0020】

さらにその上に、C（炭素）ドープの $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ （ $x=0.5, y=1$ ）層とZnドープ $p-Al_xGa_{1-x}As$ （ $x=0$ ）をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さで交互に積層した周期構造（1周期）を積層し、その上にCドープの $p-Al_xGa_{1-x}As$ （ $x=0.9$ ）とZnドープ $p-Al_xGa_{1-x}As$ （ $x=0$ ）をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さで交互に積層した周期構造（25周期）とからなる半導体分布プラッグ反射鏡（ $Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs$ 上部半導体分布プラッグ反射鏡）を形成している。この例では $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ （ $x=0.5, y=1$ ）層も上部反射鏡の一部であり、低屈折率層（屈折率小の層）となっている。

【0021】

なおここで、上部／下部反射鏡ともそれぞれ低屈折率層（屈折率小の層）／高屈折率層（屈折率大の層）を交互に積層して形成するが、本発明ではこれらの間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ （ $0 \leq y < z < x \leq 1$ ）を設けている。図2は、低屈折率層（屈折率小の層）と高屈折率層（屈折率大の層）の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ （ $0 \leq y < z < x \leq 1$ ）を設けた半導体分布プラッグ反射鏡の一部を示したものである（図1では図が複雑になるので図示することを省略している）。

【0022】

従来レーザ波長が0.85μm帯の半導体レーザに関して、このような材料層を設けることも検討はされているが、まだ検討段階であり、その材料、あるいはその厚さなどまで詳細には検討されていない。また本発明のようなレーザ発振波

長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザに関しては全く検討されていない。その理由はこの分野（レーザ発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザ）が新しい分野であり、まだほとんど研究が進んでいないからである。

【0023】

本発明者はいち早くこの分野（レーザ発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた光通信）の有用性に気付き、それを実現するために鋭意検討を行った。

【0024】

このような材料層は形成時にガス流量をコントロールするなどして、その Al 組成を連続的もしくは段階的に変えるようにしてその材料層の屈折率が連続的もしくは段階的に変化するようにして形成する。

【0025】

より具体的には、 $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) 層の z の値を 0 から 1.0 まで変わるように、つまり GaAs ~ AlGaAs ~ AlAs という具合に Al と Ga の比率が徐々に変わるようにして形成する。これは前述のように層形成時にガス流量をコントロールすることによって作成される。また、 Al と Ga の比率が前述のように連続的に変わるようにして形成しても良いし、段階的にその比率が変わることによっても同等の効果がある。

【0026】

このような材料層を設ける理由は、半導体分布プラグ反射鏡の持つ問題点の一つである p - 半導体分布プラグ反射鏡の電気抵抗が高いという課題を解決するためである。これは半導体分布プラグ反射鏡を構成する 2 種類の半導体層の界面に生じるヘテロ障壁が原因であるが、本発明のように低屈折率層と高屈折率層の界面に一方の組成から他方の組成へ次第に Al 組成が変化するようにして、屈折率も変化させることによってヘテロ障壁の発生を抑制することが可能である。

【0027】

またこのような屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ (

$0 \leq y < z < x \leq 1$) は本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu m \sim 1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの場合、 $5 nm \sim 50 nm$ の厚さとするのが良く、これより薄いと抵抗が大となり電流が流れにくく、素子が発熱したり、駆動エネルギーが高くなるという不具合がある。また厚いと抵抗が小となり、素子の発熱や、駆動エネルギーの面で有利になるが、今度は反射率がとれないという不具合があり、前述のように最適の範囲 ($5 nm \sim 50 nm$ の厚さ) を選ぶ必要がある。

【0028】

なお、前述のように従来のレーザ波長が $0.85 \mu m$ 帯の半導体レーザについてこのような材料層を設けることも検討されているが、本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu m \sim 1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの場合は、より効果的である。なぜなら、例えば同等の反射率（例えば 99.5% 以上）を得るために $0.85 \mu m$ 帯よりも $1.1 \mu m$ 帯～ $1.7 \mu m$ 帯の場合、このような材料層を約2倍程度にすることができるので、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができ、動作電圧、発振閾値電流等が低くなり、レーザ素子の発熱防止ならびに安定発振、少エネルギー駆動の面で有利となる。

【0029】

つまり半導体分布プラグ反射鏡にこのような材料層を設けることは、本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu m \sim 1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの場合に特に効果的な工夫といえる。

【0030】

なお効果的な反射率を得るためのより詳細な検討結果の一例を挙げると、例えば $1.3 \mu m$ 帯面発光型レーザ素子では、 $Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 1.0$) (低屈折率層～屈折率小の層) と $Al_yGa_{1-y}As$ ($y = 0$) (高屈折率層～屈折率大の層) を20周期積層した場合においては、半導体分布プラグ反射鏡の反射率が 99.7% 以下となる $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) 層の厚さは $30 nm$ である。また、反射率が 99.5% 以上となる波長帯域は $53 nm$ であり、反射率を 99.5% 以上と設計した場合、 $\pm 2\%$ の膜厚制御ができればよい。そこでこれと同等およびこれより薄い、 $10 nm$ 、 $20 nm$ 、 3

0 nmのものを試作したところ、反射率を実用上問題のない程度に保つことができ、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができた1. 3 μm帯面発光型レーザ素子を実現、レーザ発振に成功した。なお試作したレーザ素子の他の構成は後述のとおりである。

【0031】

なお多層膜反射鏡においては設計波長（膜厚制御が完全にできたとして）を含んで反射率の高い帯域がある。高反射率の帯域（反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域を含む）と呼ぶ。設計波長の反射率が最も高く、波長が離れるにしたがってごくわずかずつ低下している領域である。ある領域から急激に低下する。そして狙いの波長に対して必要な反射率以上となるように、本来、多層膜反射鏡の膜厚を原子層レベルで完全に制御する必要がある。しかし実際には±1 %程度の膜厚誤差は生じるので狙いの波長と最も反射率の高い波長はずれてしまう。例えば狙いの波長が1. 3 μmの場合、膜厚制御が1 %ずれたとき、最も反射率の高い波長は1.3 nmずれてしまう。よってこの高反射率の帯域（ここでは反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域）は広い方が望ましい。しかし中間層を厚くするとこの帯域が狭くなる傾向にある。

【0032】

このように本発明のようなレーザ発振波長が1. 1 μm～1. 7 μmの長波長帯面発光半導体レーザにおいて、このような半導体分布プラグ反射鏡の構成を工夫、最適化することにより、反射率を高く維持したまま抵抗値を低減させることができるので、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱防止ならびに安定発振、少エネルギー駆動が可能となる。

【0033】

再び図1に戻り、最上部の、 $p-Al_xGa_{1-x}As$ ($x=0$) 層は、電極とコンタクトを取るためのコンタクト層（p-コンタクト層）としての役割も持っている。

【0034】

ここで、量子井戸活性層のIn組成xは39% (Ga0.61In0.39As)とした。また量子井戸活性層の厚さは7 nmとした。なお量子井戸活性層は、GaAs基板

に対して約2.8%の圧縮歪を有していた。

【0035】

またこの面発光型半導体レーザ全体の成長方法はMOCVD法で行った。この場合、格子緩和は見られなかった。半導体レーザの各層を構成する原料には、TMA（トリメチルアルミニウム）、TMG（トリメチルガリウム）、TMI（トリメチルインジウム）、AsH₃（アルシン）、PH₃（fosfin）を用いた。また、キャリアガスにはH₂を用いた。図1に示した素子の活性層（量子井戸活性層）のように歪が大きい場合は、非平衡となる低温成長が好ましい。ここでは、GaInAs層（量子井戸活性層）は550°Cで成長させている。ここで使用したMOCVD法は過飽和度が高く高歪活性層の結晶成長に適している。またMBE法のような高真空中を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0036】

またこの例では、電流経路外の部分をプロトン(H⁺)照射によって絶縁層（高抵抗部）を作り、電流狭さく部を形成した。

【0037】

そしてこの例では、上部反射鏡の最上部の層であり上部反射鏡一部となっているp-コンタクト層上に光出射部を除いてp側電極を形成し、基板の裏面にn側電極を形成した。

【0038】

この例では、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域（本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器）において、活性領域内にはAlを含んだ材料（III族に占める割合が1%以上）を用いず、さらに、下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層をGa_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(0 < x < 1, 0 < y ≤ 1)の非発光再結合防止層としている。キャリアは、活性層に最も近くワイドギャップである上部及び下部反射鏡の低屈折率層間に閉じ込められるので、活性領域のみをAlを含まない層（II族に占める割合が1%以下）で構成しても活性領域に接する反射鏡の低屈折率層（ワイドギャップ層）にAlを含んだ構造としたのでは、キャリアが注入され

再結合する時、この界面で非発光再結合が生じ発光効率は低下してしまう。よって活性領域はA1を含まない層で構成することが望ましい。

【0039】

この例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面にA1を含まない構成としたので、キャリア注入時にA1に起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合がなくなり、非発光再結合が低減した。

【0040】

前述のように、反射鏡と活性領域との界面にA1を含まない構成とする、すなわち非発光再結合防止層を設けることを、上下反射鏡ともに適用することが好ましいが、一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラグ反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラグ反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。また前述の例では、反射鏡低屈折率層の最も活性層に近い層のみを $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としているが、複数層の $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) を非発光再結合防止層としても良い。

【0041】

さらにこの例では、GaAs基板と活性層との間の下部反射鏡にこの考えを適用し、活性層の成長時に問題となる、A1に起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。これらにより、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分をA1を含まない $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) 層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができている。

【0042】

このようにして製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約1.2μmであった。GaAs基板上のGaInAsは、In組成の増加で長波長化するが歪み量の増加をともない、従来1.1μmまでが長波長化の限界と考えられていた（文献「IEEE Photonics Technol. Lett. Vol. 9

(1997) p.p. 1319-1321」参照)。

【0043】

しかしながら今回発明者が製作したように、600°C以下の低温成長などの非平衡度の高い成長法により高歪のGaInAs量子井戸活性層を従来より厚くコヒーレント成長することが可能となり、波長は1.2 μmまで到達できた。なおこの波長はSi半導体基板に対して透明である。従ってSi基板上に電子素子と光素子を集積した回路チップにおいてSi基板を通した光伝送が可能となる。

【0044】

以上の説明より明らかなようにIn組成が大きい高圧縮歪のGaInAsを活性層に用いることにより、GaAs基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できることがわかった。

【0045】

なお前述のように、このような面発光型半導体レーザは、MOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また活性層の積層構造として、3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、MQW)等を用いることもできる。

【0046】

レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。また共振器長はλの厚さとしたがλ/2の整数倍とすることができる。望ましくはλの整数倍である。また半導体基板としてGaAsを用いた例を示したが、InPなどの他の半導体基板を用いた場合でも上記の考え方を適用できる。反射鏡の周期は他の周期でも良い。

【0047】

なおこの例では活性層として、主たる元素がGa、In、Asよりなる層、すなわち $Ga_xIn_{1-x}As$ (GaInAs活性層)の例を示したが、より長波長のレーザ発振を行うためには、Nを添加し主たる元素がGa、In、N、Asからなる層(GaInNAs活性層)とすればよい。

【0048】

実際にGaInNAs活性層の組成を変えることにより、1.3 μm帯、1.55 μm帯のそれぞれにおいて、レーザ発振を行うことが可能であった。組成を

検討することにより、さらに長波長の例えは1. 7 μm帯の面発光レーザも可能となる。

【0049】

また、活性層にGaAsSbを用いてもGaAs基板上に1. 3 μm帯面発光レーザを実現できる。このように波長1. 1 μm～1. 7 μmの半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪のGaInAs、GaInNAs、GaAsSbを用い、かつ、非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長1. 1 μm～1. 7 μm帯の長波長領域において、高性能な面発光レーザを実現できるようになった。

【0050】

次に本発明の光送受信システムに適用される発光素子である長波長帯面発光型半導体レーザの他の構成について、図3を用いて説明する。

【0051】

この場合も図1の場合と同様に面方位(100)のn-GaAs基板を使用している。それぞれの媒質内における発振波長λの1/4倍の厚さ(λ/4の厚さ)でn-Al_xGa_{1-x}As(x=0.9)とn-Al_xGa_{1-x}As(x=0)を交互に35周期積層したn-半導体分布プラグ反射鏡(Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs下部反射鏡)を形成し、その上にλ/4の厚さのn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5, y=1)層を積層した。この例ではn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5, y=1)層も下部反射鏡の一部であり低屈折率層となっている。

【0052】

そしてその上に、アンドープ下部GaAsスペーサ層と、3層のGa_xIn_{1-x}N_yAs_{1-y}量子井戸層である活性層(量子井戸活性層)とGaAsバリア層(15nm)から構成される多重量子井戸活性層(この例では3重量子井戸(TQW))と、アンドープ上部GaAsスペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長の1波長分の厚さ(λの厚さ)の共振器を形成している。

【0053】

さらにその上に、p-半導体分布プラグ反射鏡(上部反射鏡)が形成されている。

【0054】

上部反射鏡は、被選択酸化層となるAlAs層を、GaInP層とAlGaAs層で挟んだ $3\lambda/4$ の厚さの低屈折率層（厚さが $(\lambda/4 - 15\text{ nm})$ ）のCドープp-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}（x=0.5, y=1）層、Cドープp-Al_zGa_{1-z}As（z=1）被選択酸化層（厚さ30nm）、厚さが $(2\lambda/4 - 15\text{ nm})$ のCドープp-Al_xGa_{1-x}As層（x=0.9）と、厚さが $\lambda/4$ のGaAs層（1周期）と、Cドープのp-Al_xGa_{1-x}As層（x=0.9）とp-Al_xGa_{1-x}As（x=0）層をそれぞれの媒質内における発振波長の $1/4$ 倍の厚さで交互に積層した周期構造（22周期）とから構成されている半導体分布プラグ反射鏡（Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs上部反射鏡）である。

【0055】

なおこの例においても、図3では複雑になるので図示することは省略しているが、半導体分布プラグ反射鏡の構造は、図2に示したような低屈折率層（屈折率小の層）と高屈折率層（屈折率大の層）の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層Al_zGa_{1-z}As（ $0 \leq y < z < x \leq 1$ ）を設けたものである。

【0056】

そして、最上部の、p-Al_xGa_{1-x}As（x=0）層は、電極とコンタクトを取るためのコンタクト層（p-コンタクト層）としての役割も持たせている。

【0057】

ここで量子井戸活性層のIn組成xは37%、N（窒素）組成は0.5%とした。また量子井戸活性層の厚さは7nmとした。

【0058】

またこの面発光型半導体レーザの成長方法はMOCVD法を行った。半導体レーザの各層を構成する原料には、TMA（トリメチルアルミニウム）、TMG（トリメチルガリウム）、TMI（トリメチルインジウム）、AsH₃（アルシン）、PH₃（fosfin）、そして窒素の原料にはDMHy（ジメチルヒドラン）を用いた。DMHyは低温で分解するので600°C以下の低温成長に適しており、特に低温成長の必要な歪みの大きい量子井戸層を成長する場合に好ましい。なおキャリアガスにはH₂を用いた。

【0059】

またこの例では、 GaInNAs 層（量子井戸活性層）は540°Cで成長した。MOCVD法は過飽和度が高くNと他のV族を同時に含んだ材料の結晶成長に適している。またMBE法のような高真空を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0060】

さらにこの例では、所定の大きさのメサ部分を $p-\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ ($x=0.5, y=1$)層に達するまで、 $p-\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($z=1$)被選択酸化層の側面を露出させて形成し、側面の現れた $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($z=1$)層を水蒸気で側面から酸化して Al_xO_y 電流狭さく層を形成している。

【0061】

最後にポリイミド（絶縁膜）でメサエッチングで除去した部分を埋め込んで平坦化し、上部反射鏡上のポリイミドを除去し、p-コンタクト層上に光出射部を除いてp側電極を形成し、 GaAs 基板の裏面にn側電極を形成した。

【0062】

この例においては、被選択酸化層の下部に上部反射鏡の一部として $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$)層が挿入している。例えばウェットエッチングの場合では、硫酸系エッチャントを用いれば、 AlGaAs 系に対して GaInPAs 系はエッチング停止層として用いることができるため、 $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$)層が挿入されていることで、選択酸化のためのメサエッチングの高さを厳密に制御できる。このため、均一性、再現性を高められ、低コスト化が図れる。

【0063】

またこの例の面発光型半導体レーザ（素子）を一次元または二次元に集積した場合、素子製作時における制御性が良好になることにより、アレイ内の各素子の素子特性の均一性、再現性も極めて良好になるという効果がある。

【0064】

なおこの例では、エッチングストップ層を兼ねる $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$)層を上部反射鏡側に設けたが、下部反射鏡側に設けても良

い。

【0065】

またこの例においても、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域（本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器）において、活性領域内にはA₁を含んだ材料を用いず、さらに下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層をGa_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}（0 < x < 1、0 < y ≤ 1）の非発光再結合防止層としている。つまりこの例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面に、A₁を含まない構成としているので、キャリア注入時に、A₁に起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合を低減させることができる。

【0066】

なお反射鏡と活性領域との界面にA₁を含まない構成を、この例のように上下反射鏡に適用することが好ましいが、いずれか一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラグ反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラグ反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。

【0067】

さらにこの例でも、GaAs基板と活性層との間の下部反射鏡に図1の例の場合と同様の考えを適用したので、活性層の成長時に問題となるA₁に起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。

【0068】

なお、このような非発光再結合防止層は、図1、図3のいずれの構成においても半導体分布プラグ反射鏡の一部を構成するので、その厚さは、媒質内における発振波長λの1/4倍の厚さ（λ/4の厚さ）としている。あるいはそれを複数層も設けても良い。

【0069】

以上の説明より明らかのように、このような構成により、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラッ

グ反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分を Al を含まない $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができた。

【0070】

またこのような構成にしても、ポリイミドの埋め込みは容易であるので、配線（この例では p 側電極）が段切れしにくく、素子の信頼性は高いものが得られる

【0071】

このように製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約 $1.3\mu m$ であった

【0072】

この例では、主たる元素が Ga、In、N、As からなる層を活性層に用いた (GaInNAs 活性層) ので、GaAs 基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できた。また Al と As を主成分とした被選択酸化層の選択酸化により電流狭さくを行ったので、しきい値電流は低かった。

【0073】

被選択酸化層を選択酸化した Al 酸化膜からなる電流狭さく層を用いた電流狭さく構造によると、電流狭さく層を活性層に近づけて形成することで電流の広がりを抑えられ、大気に触れない微小領域に効率良くキャリアを閉じ込めることができる。更に酸化して Al 酸化膜となることで屈折率が小さくなり凸レンズの効果でキャリアの閉じ込められた微小領域に効率良く光を閉じ込めることができ、極めて効率が良くなり、しきい値電流は低減できる。また容易に電流狭さく構造を形成できることから、製造コストを低減できる。

【0074】

以上の説明から明らかなように図 3 のような構成においても図 1 の場合と同様に、 $1.3\mu m$ 帯の面発光型半導体レーザを実現でき、しかも低消費電力で低コストの素子が得られる。

【0075】

なお、図3の面発光型半導体レーザも図1の場合と同様にMOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また窒素の原料に、DMHyを用いたが、活性化した窒素やNH₃等他の窒素化合物を用いることもできる。

【0076】

さらに活性層の積層構造として3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、DQW、MQW)等を用いることもできる。レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。

【0077】

また図3の面発光型半導体レーザにおいて、GaInNAs活性層の組成を変えることで、1.55μm帯、更にはもっと長波長の1.7μm帯の面発光型半導体レーザも可能となる。GaInNAs活性層にTl、Sb、Pなど他のIII-V族元素が含まれていてもかまわない。また活性層にGaAsSbを用いても、GaAs基板上に1.3μm帯の面発光型半導体レーザを実現できる。

【0078】

なお活性層にGaInNAsを用いた場合、従来1.1μmまでが長波長化の限界と考えられていたが、600℃以下の低温成長により高歪のGaInNAs量子井戸活性層を従来よりも厚く成長することが可能となり、波長は1.2μmまで到達できる。このように、波長1.1μm～1.7μmの半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪のGaInNAs、GaInNAs、GaAsSbを用い、かつ非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長1.1μm～1.7μm帯の長波長領域において、高性能な面発光レーザを実現できるようになり、光通信システムへの応用ができるようになった。

【0079】

図4はこのような長波長帶面発光半導体レーザ素子を、面方位(100)のn-GaAsウエハに多数のチップとして形成した例、ならびにレーザ素子チップを示したものである。こので示したレーザ素子チップには、1～n個のレーザ素子が形成されているが、その個数nはその用途に応じて、数ならびに配列方法が

決められる。

【0080】

図5は長波長帯面発光半導体レーザを用いた通信システムの一例であり、当該面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルと、それに接続される通信用光ファイバーを示したものである。ここで、モジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルと、それに接続される通信用光ファイバーとは、例えば融着等によって接続されるが、その際一定の接続しろが必要とされる。特にモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルについては、図5に示したガイド用光ファイバー長 L_g が短かすぎるとこのようなモジュールパッケージをアセンブリ製作する際に大変細かい作業を強いられ、アセンブリ製作コストの面から不利になるし、また高精度なモジュールパッケージを製作するうえでも不利になる。

【0081】

通常本発明のような通信システムに使用される光ファイバーは、大変微細なものであり、その径は、 $50\text{ }\mu\text{m}$ とか $62.5\text{ }\mu\text{m}$ というようなものである。よってこのようなモジュールパッケージをアセンブリ製作する際に、光ファイバーを例えばピンセットのような工具を使ってはさんだりしてアセンブリ製作作業を行うわけであるが、この光ファイバーの長さ L_g をある値以上にしないと、ピンセット等によってつかむことが困難となる。

【0082】

あるいはこのようなアセンブリ製作作業を自動化装置によって行うこともできる。その際も、このような光ファイバーをつかむワークが必要になるが、ワークの先端部、すなわち実際に光ファイバーをつかむ部分におけるつかみやすさを考慮すると、この光ファイバーの長さ L_g をある値以上にする必要がある。

【0083】

本発明者は、このようなアセンブリ製作作業をスムーズに行うことの重要性にいち早く気付き、アセンブリ製作するプロセスを銳意検討、各種試作を通じて、図5に示した長さ L_g を、少なくとも mm のオーダーが必要であることを見出し

た。すなわち本発明のような、長波長面発光半導体レーザを用いた通信システムの面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルの長さ L_g （図5のガイド用光ファイバー長 L_g ）は、1mm以上とすることが必要であることを見出した。

【0084】

仮にこの部分の長さを、mmのオーダーではなく、光ファイバー径と同様に μm オーダーとすることも考えられなくはないが、その場合はアセンブリ製作作業は、高額でかつ高精度で高度に機械化され、しかも顕微鏡下で行うという大変生産性の低い作業となる。よって現実問題としては、工業的にみて実用的とはいいがたいものとなる。

【0085】

なおこのようなガイド用光ファイバーは、図5の接続する光通信システムの光ファイバーに例えば融着によって接続されるが、その際、実際にガイド用光ファイバーの端面が熔けるのでその融着しろ（図6のマージン G_m ）の観点から考慮してもmmのオーダーが必要とされる。

【0086】

本発明者はこの点について、実際に融着の実験を行い、その融着しろに要求される長さを検討した。その結果、ガイド用光ファイバー長 L_g が μm オーダーの場合には（実際には、 $200 \mu m$ 、 $500 \mu m$ 、 $900 \mu m$ ）、端面が熔けすぎて良好な接合ができなかった。一方で1mm以上とした場合は（実際には、1mm、3mm）、良好な接合ができた。

【0087】

つまり、このようなガイド用光ファイバーの光ファイバーケーブル長さ L_g は、モジュールのアセンブリ製作の観点から、また光通信システムの光ファイバーとの接続の観点から、1mm以上必要である。

【0088】

なお、その上限については、アセンブリ製作の観点からもまた光通信システムの光ファイバーとの接続の観点からも、20mmもあれば十分である。また、2

0 mmが長すぎればモジュールのアセンブリ後に適宜切断し、必要な長さにして接続すればよい。

【0089】

次に本発明の他の特徴について説明する。上記説明は、光源である面発光型半導体レーザ素子とそれに最初につながるガイド用光ファイバーの関係を論じたものであるが、ここではその網一方の受光側について検討した。

【0090】

図は省略するが、図5、図6の面発光型半導体レーザをフォトダイオード等の受光素子と置き換えて考えると、受光側については、受光素子とこの受光素子と最初に光カップリングされる光ファイバー（図5、図6のガイド用光ファイバーに相当）とよりなる受光ユニットが存在する。

【0091】

この受光ユニットについても、上記発光側のモジュールパッケージと同様に、アセンブリ製作の観点ならびに光通信システムの光ファイバーとの接続の観点から、同様の考え方が必要である。

【0092】

本発明では、この受光ユニットに関しても、この受光素子と最初に光カップリングされる光ファイバー（図5、図6のガイド用光ファイバーに相当）の長さを1 mm以上とすることにより、受光ユニットの実用的なアセンブリ製作の実現ならびに光通信システムの光ファイバーとの信頼性の高い接続ができるようにしている。

【0093】

なお、その上限についても、発光側のモジュールパッケージと同様に20 mmもあれば十分である。

【0094】

【発明の効果】

【請求項1に対応した効果】

コンピュータ・ネットワーク、長距離大容量通信の幹線系など光ファイバー通信が期待されているレーザ発振波長が1.1 μm帯～1.7 μm帯の分野において

て、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱も少なく安定した発振ができる面発光型半導体レーザおよびそれを用いた通信システムが存在しなかつたが、本発明のように半導体分布プラグ反射鏡を工夫することにより、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱も少なく安定した発振ができ、また低成本で実用的な光通信システムが実現できた。

【0095】

さらに、従来、このようなレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}$ 帯～ $1.7\text{ }\mu\text{m}$ 帯の分野における実用的な光通信システムが無かったことにより、これに使用される面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長をどのようにすればよいのかという検討がされてこなかったが、本発明のようにこの長さを 1 mm 以上とすることで当該パッケージのアセンブリ製作の生産性を著しく向上させることができた。

【0096】

さらに当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーに伝送用のファイバーケーブルを接続して光通信システムを構築する際にも、上記のようにこの光ファイバーの長さを 1 mm 以上とすることでそれらの接続が容易にかつ確実に行えるようになり、信頼性の高い光通信システムが容易に構築できるようになった。

【0097】

〔請求項2に対応した効果〕

コンピュータ・ネットワーク、長距離大容量通信の幹線系など光ファイバー通信が期待されているレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}$ 帯～ $1.7\text{ }\mu\text{m}$ 帯の分野において、安定して使用できる長波長帶面発光半導体レーザおよびそれを用いた通信システムが存在しなかつたが、本発明のように、非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップとすることにより安定した発振が可能となり、これを発光光源とした実用的な光通信システムが実現できた。

【0098】

さらに、従来、このようなレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}$ 帯～ $1.7\text{ }\mu\text{m}$ 帯の分

野における実用的な光通信システムが無かったことにより、これに使用される面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長をどのようにすればよいのかという検討がされてこなかったが、本発明のようにこの長さを1mm以上とすることによって当該パッケージのアセンブリ製作の生産性を著しく向上させることができた。

【0099】

さらに当該チップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーに伝送用のファイバーケーブルを接続して光通信システムを構築する際にも、上記のようにこの光ファイバーの長さを1mm以上とすることでそれらの接続が容易にかつ確実に行えるようになり、信頼性の高い光通信システムが容易に構築できるようになった。

【0100】

〔請求項3に対応した効果〕

コンピュータ・ネットワーク、長距離大容量通信の幹線系など光ファイバー通信が期待されているレーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の分野において、安定して使用できる長波長帶面発光半導体レーザおよびそれを用いた通信システムが存在しなかったが、本発明のように半導体分布プラグ反射鏡を工夫したり、あるいは非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップとすることにより、レーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の分野において実用的な面発光型半導体レーザ素子チップが実現し、それを利用した光送受信システムが構築できるようになった。

【0101】

さらに、従来、このようなレーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の分野における実用的な光送受信システムが無かったことにより、これに使用される受光ユニットから引き出される光ファイバーケーブルのファイバーケーブル長をどのようにすればよいのかという検討がされてこなかったが、本発明のように、この長さを1mm以上とすることにより、受光ユニットのアセンブリ製作の生産性を著しく向上させることができた。

【0102】

さらに受光ユニットから引き出される光ファイバーに伝送用のファイバーケーブルを接続して光送受信システムを構築する際に、上記のようにこの光ファイバーの長さを1mm以上とすることでそれらの接続が容易にかつ確実に行えるようになり、信頼性の高い光送受信システムが容易に構築できるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの素子部断面図である。

【図2】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの半導体分布プラグ反射鏡の構成の部分断面図である。

【図3】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの他の構成の素子部断面図である。

【図4】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザ素子を形成したウエハ基板ならびにレーザ素子チップを示す平面図である。

【図5】

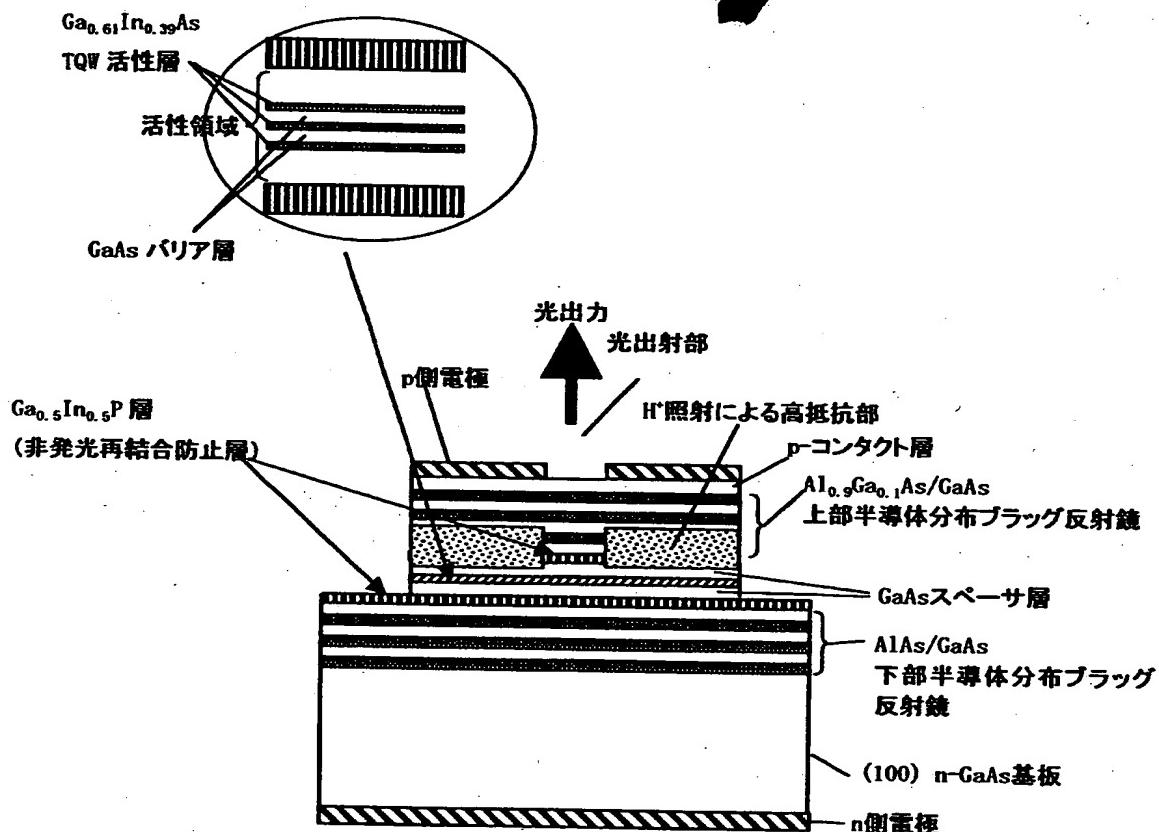
本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザおよび接続する光通信システムの接続図である。

【図6】

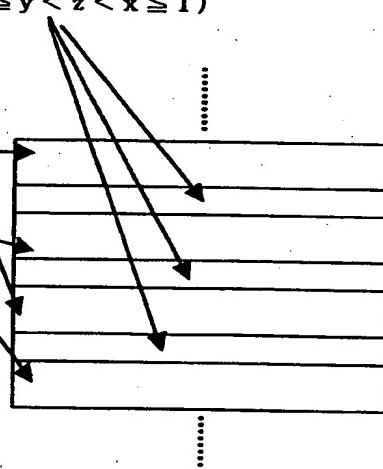
本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザおよび接続する光通信システムの接続におけるガイド用光ファイバー長を示す図面である。

【書類名】 図面

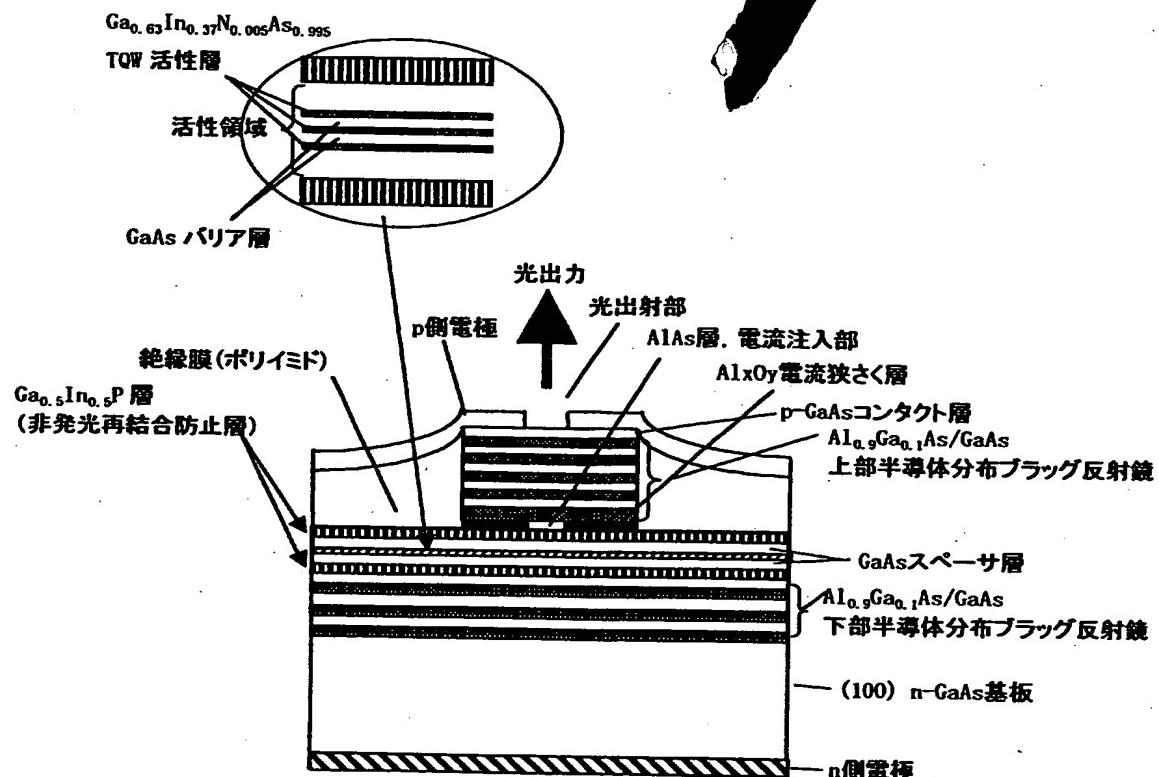
【図1】



【図2】

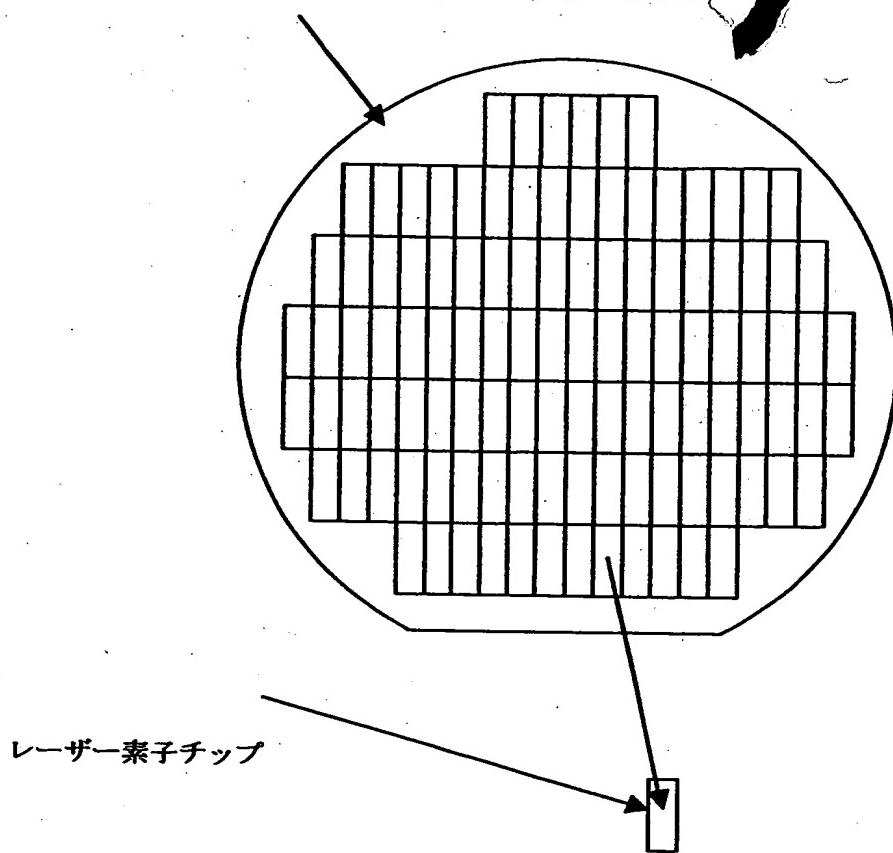
屈折率が小と大の間の値をとる材料層 Al_zGa_{1-z}As ($0 \leq y < z < x \leq 1$)屈折率が大の材料層 Al_yGa_{1-y}As ($0 \leq y < x \leq 1$)屈折率が小の材料層 Al_xGa_{1-x}As ($0 < x \leq 1$)

【図3】

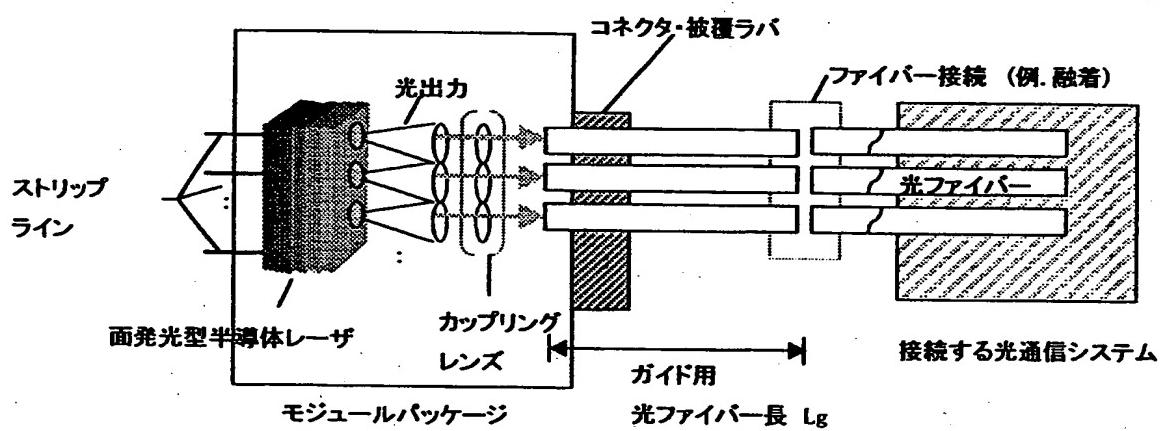
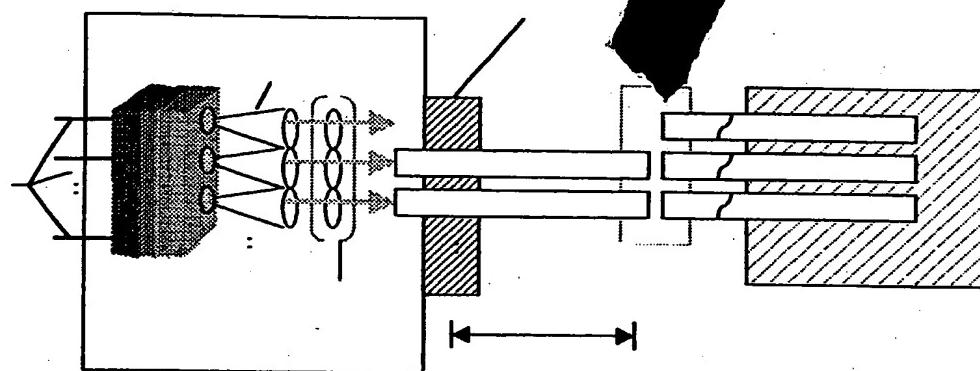


【図4】

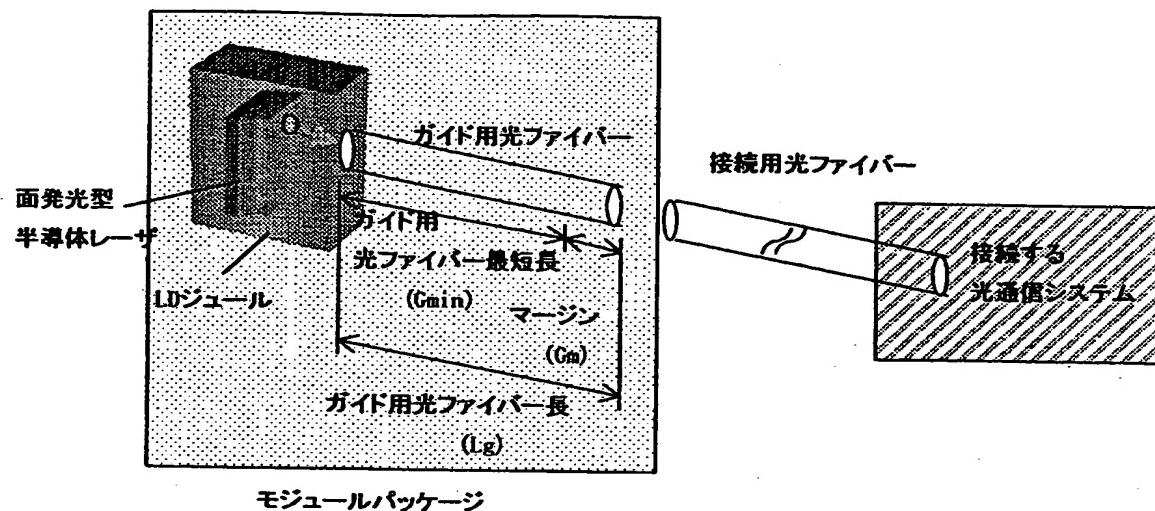
レーザー素子を形成した (100) n-GaA



【図5】



【図6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 面発光半導体レーザ素子チップを収容するパッケージのアセンブリの生産性の向上を図り、容易に光通信システムを構築できるようにする。

【解決手段】 長波長帯面発光型半導体レーザ素子チップ、もしくは、このチップを収容するモジュールパッケージから引き出される光ファイバーケーブルの長さ L_g を1ミリメートル以上の長さにする。仮にこの長さを光ファイバー径と同様の μm オーダーの長さとした場合は、アセンブリ作業において高額かつ高精度の機械を用いて顕微鏡下で行う必要があり、大変生産性の低いものとなる。これに対し、本発明は光ファイバー長を mm オーダーの長さとすることによりアセンブリ作業において、ピンセット等による手作業および機械による自動化作業において容易性が確保され、信頼性の高い光通信システムを構築することができる。

【選択図】 図5

出願人履歴情報

識別番号 [000006747]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
氏 名 株式会社リコー